

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第1区分

【発行日】平成25年11月28日(2013.11.28)

【公表番号】特表2013-511799(P2013-511799A)

【公表日】平成25年4月4日(2013.4.4)

【年通号数】公開・登録公報2013-016

【出願番号】特願2012-539224(P2012-539224)

【国際特許分類】

H 01 M 8/02 (2006.01)

H 01 M 8/12 (2006.01)

【F I】

H 01 M 8/02 E

H 01 M 8/02 K

H 01 M 8/12

【手続補正書】

【提出日】平成25年10月7日(2013.10.7)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 2 3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 2 3】

好ましくは、アダプテーション層は、平均表面粗さとして、 $2.5 \mu m$ 未満、好ましくは大きくとも $1.5 \mu m$ 、更に好ましくは大きくても $1.0 \mu m$ の二乗平均粗さ値 R_q を有する。 $2.5 \mu m$ を超える二乗平均粗さ値 R_q は、次の薄層電解質において潜在的な漏れを招く。それで、例えば次のPVD層の成長の際に柱間の中間スペースが生じ得る。ゾル・ゲル薄層電解質では、より大きい粗さ値は、プロファイルの先端部の濡れがもはや保証され得ないということかまたはプロファイルの谷において臨界的な層厚を超えてしまい、これが薄層電解質の割れを起こすということを招く。